

D10XB□

800V 10A

## 特長

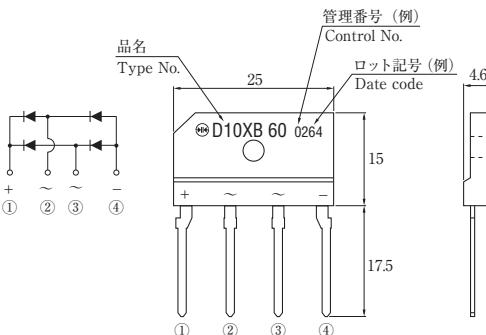
- ・薄型 SIP パッケージ
- ・UL E142422
- ・大電流容量
- ・高耐圧・高  $I_{F\text{SM}}$
- ・高放熱伝導性

## Feature

- ・Thin-SIP
- ・UL E142422
- ・Large  $I_o$
- ・High Voltage・Large  $I_{F\text{SM}}$
- ・High Thermal Radiation

## ■外観図 OUTLINE

Package : 3S

Unit : mm  
Weight : 4.4g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

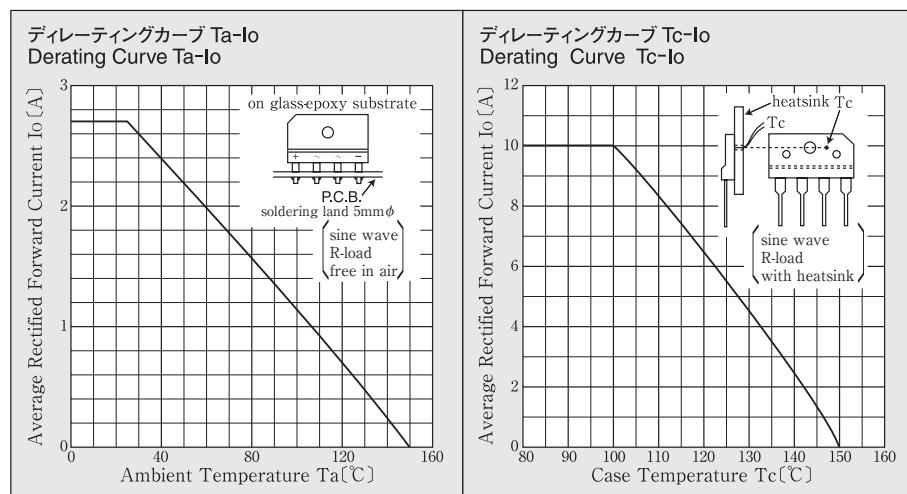
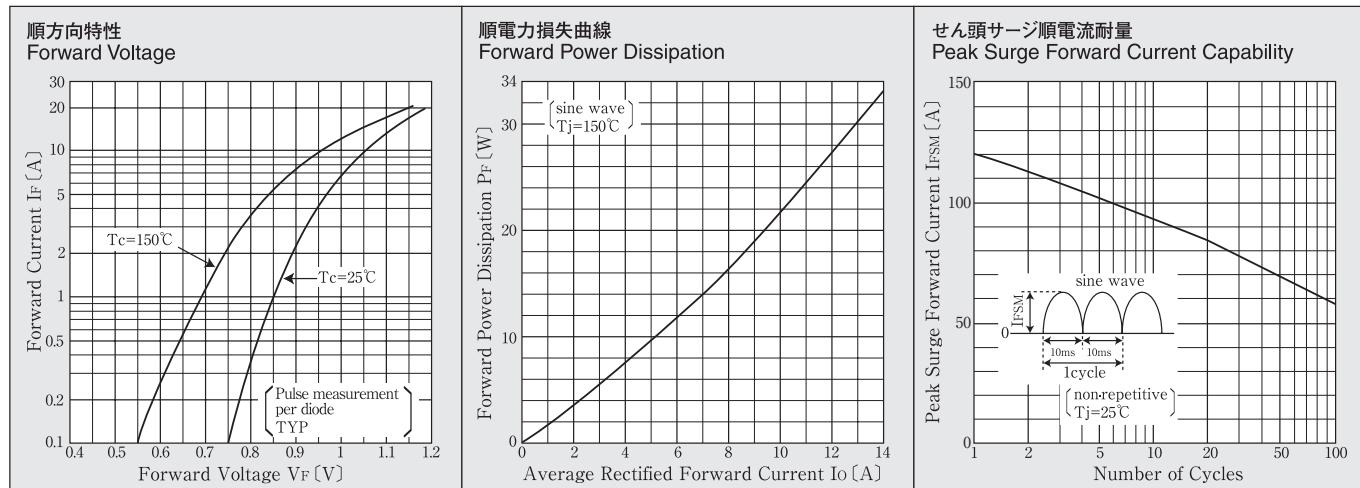
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D10XB60	D10XB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T <sub>j</sub>			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>		600	800		V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink $T_c=100^\circ\text{C}$	10		A
			フィンなし Without heatsink $T_a=25^\circ\text{C}$	2.7		
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		120		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I <sup>2</sup> t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$ , $T_j=25^\circ\text{C}$ , 1 素子当たりの規格値 per diode		60		A <sup>2</sup> s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5		kV
締め付けトルク Mounting Torque	T <sub>OR</sub>	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque: 0.5 N·m)		0.8		N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =5A, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 2.3	°C/W
	θ <sub>jl</sub>	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6	
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 26	

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- \* Sine wave は 50Hz で測定しています。
- \* 50Hz sine wave is used for measurements.
- \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- \* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.